

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-n-p* универсальный. Предназначен для применения в ключевых схемах, импульсных модуляторах, преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. На корпус наносят условный знак "5А". Масса транзистора не более 0,07 г. Габаритный чертеж корпуса см. КТ9145А9.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_b = 10$ мА	20...40*...150
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 10$ мА	30...35*...40* МГц
Граничное напряжение при $I_k = 30$ мА, не менее	300 В
типовое значение	380* В
Напряжение насыщения коллектор - эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 2$ мА, не более	0,6 В
Напряжение насыщения база - эмиттер при $I_k = 10$ мА, $I_b = 2$ мА	0,7*...0,8*...1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 500$ В, не более	1 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5$ В, не более	1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор - база	500 В
Постоянное напряжение коллектор - эмиттер при $R_{бэ} = 1$ кОм, $dU_{кз}/dt = 250$ В/мкс	500 В
Постоянное напряжение эмиттер - база	5 В
Постоянный ток коллектора	50 мА
Импульсный ток коллектора при $t_n = 500$ мкс, $Q = 2$	100 мА
Постоянный ток базы	5 мА
Импульсный ток базы при $t_n = 500$ мкс, $Q = 2$	10 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_k = -60...+25^{\circ}\text{C}$: с теплоотводом ¹	1 Вт
без теплоотвода ²	0,3 Вт
Температура <i>p-n</i> перехода	+150°C
Тепловое сопротивление переход - корпус	125°C/Вт
Тепловое сопротивление переход - среда	416°C/Вт
Температура окружающей среды	-60°C... $T_k = +100^{\circ}\text{C}$

¹ При $T_k > +25^{\circ}\text{C}$ постоянная рассеиваемая мощность коллектора определяется из выражения

$$P_{к, \max} = (150 - T_k) / 125, \text{ Вт}$$

² При $T > +25^{\circ}\text{C}$

$$P_{к, \max} = (150 - T) / 416, \text{ Вт}$$